



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109308873 A

(43)申请公布日 2019.02.05

(21)申请号 201710617136.0

(22)申请日 2017.07.26

(71)申请人 何学军

地址 210000 江苏省南京市秦淮区小火瓦
巷益乐村8号6楼

(72)发明人 何学军

(51)Int.Cl.

G09G 3/3225(2016.01)

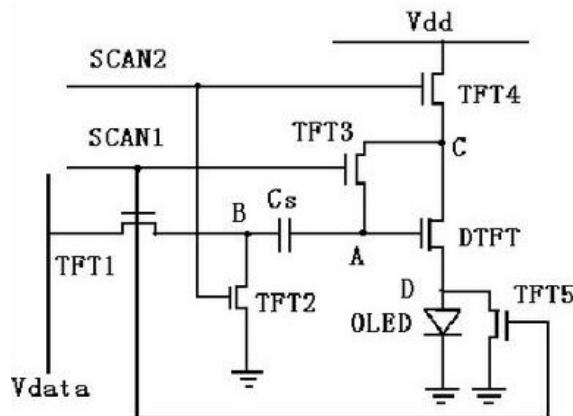
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种像素电路

(57)摘要

本发明公开了一种像素电路，包括：第一晶体管TFT1、第二晶体管TFT2、第三晶体管TFT3、第四晶体管TFT4、第五晶体管TFT5、电容CS、有机发光二极管OLED和晶体管DTFT。本发明的有益效果为：电路结构简单，成本较低，所用电子元器件较少。



1. 一种像素电路，其特征在于，包括：第一晶体管TFT1、第二晶体管TFT2、第三晶体管TFT3、第四晶体管TFT4、第五晶体管TFT5、电容CS、有机发光二极管OLED和晶体管DTFT；第四晶体管TFT4的基极连接到第二晶体管TFT2的基极，第四晶体管TFT4的集电极连接电源，第四晶体管TFT4的发射极连接到晶体管DTFT的集电极；第三晶体管TFT3的基极连接第一晶体管TFT1的基极后连接到第五晶体管TFT5的基极，第三晶体管TFT3的集电极连接在第四晶体管TFT4的发射极与晶体管DTFT的集电极之间，第三晶体管TFT3的发射极连接在电容CS和晶体管DTFT的基极之间；第一晶体管TFT1的发射极直接连接到Vdata，第一晶体管TFT1的集电极连接电容CS后连接到晶体管DTFT的基极；第二晶体管TFT2的基极连接到第四晶体管TFT4的基极，第二晶体管TFT2的发射极直接接地；晶体管DTFT的发射极连接有机发光二极管OLED后接地，第五晶体管TFT5的集电极连接在晶体管DTFT的发射极与有机发光二极管之间，第五晶体管TFT5的发射极直接接地。

一种像素电路

技术领域

[0001] 本发明涉及电路技术领域,尤其是一种像素电路。

背景技术

[0002] 现有技术中,像素电路大多结构复杂,所用电子元器件较多,功能单一,成本高昂。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题在于,提供一种像素电路,电路结构简单,成本较低,所用电子元器件较少。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明提供一种像素电路,包括:第一晶体管TFT1、第二晶体管TFT2、第三晶体管TFT3、第四晶体管TFT4、第五晶体管TFT5、电容CS、有机发光二极管OLED和晶体管DTFT;第四晶体管TFT4的基极连接到第二晶体管TFT2的基极,第四晶体管TFT4的集电极连接电源,第四晶体管TFT4的发射极连接到晶体管DTFT的集电极;第三晶体管TFT3的基极连接第一晶体管TFT1的基极后连接到第五晶体管TFT5的基极,第三晶体管TFT3的集电极连接在第四晶体管TFT4的发射极与晶体管DTFT的集电极之间,第三晶体管TFT3的发射极连接在电容CS和晶体管DTFT的基极之间;第一晶体管TFT1的发射极直接连接到Vdata,第一晶体管TFT1的集电极连接电容CS后连接到晶体管DTFT的基极;第二晶体管TFT2的基极连接到第四晶体管TFT4的基极,第二晶体管TFT2的发射极直接接地;晶体管DTFT的发射极连接有机发光二极管OLED后接地,第五晶体管TFT5的集电极连接在晶体管DTFT的发射极与有机发光二极管之间,第五晶体管TFT5的发射极直接接地。

[0005] 本发明的有益效果为:电路结构简单,成本较低,所用电子元器件较少。

附图说明

[0006] 图1是本发明的电路结构示意图。

具体实施方式

[0007] 如图1所示,一种像素电路,包括:第一晶体管TFT1、第二晶体管TFT2、第三晶体管TFT3、第四晶体管TFT4、第五晶体管TFT5、电容CS、有机发光二极管OLED和晶体管DTFT;第四晶体管TFT4的基极连接到第二晶体管TFT2的基极,第四晶体管TFT4的集电极连接电源,第四晶体管TFT4的发射极连接到晶体管DTFT的集电极;第三晶体管TFT3的基极连接第一晶体管TFT1的基极后连接到第五晶体管TFT5的基极,第三晶体管TFT3的集电极连接在第四晶体管TFT4的发射极与晶体管DTFT的集电极之间,第三晶体管TFT3的发射极连接在电容CS和晶体管DTFT的基极之间;第一晶体管TFT1的发射极直接连接到Vdata,第一晶体管TFT1的集电极连接电容CS后连接到晶体管DTFT的基极;第二晶体管TFT2的基极连接到第四晶体管TFT4的基极,第二晶体管TFT2的发射极直接接地;晶体管DTFT的发射极连接有机发光二极管OLED后接地,第五晶体管TFT5的集电极连接在晶体管DTFT的发射极与有机发光二极管之

间,第五晶体管TFT5的发射极直接接地。

[0008] 尽管本发明就优选实施方式进行了示意和描述,但本领域的技术人员应当理解,只要不超出本发明的权利要求所限定的范围,可以对本发明进行各种变化和修改。

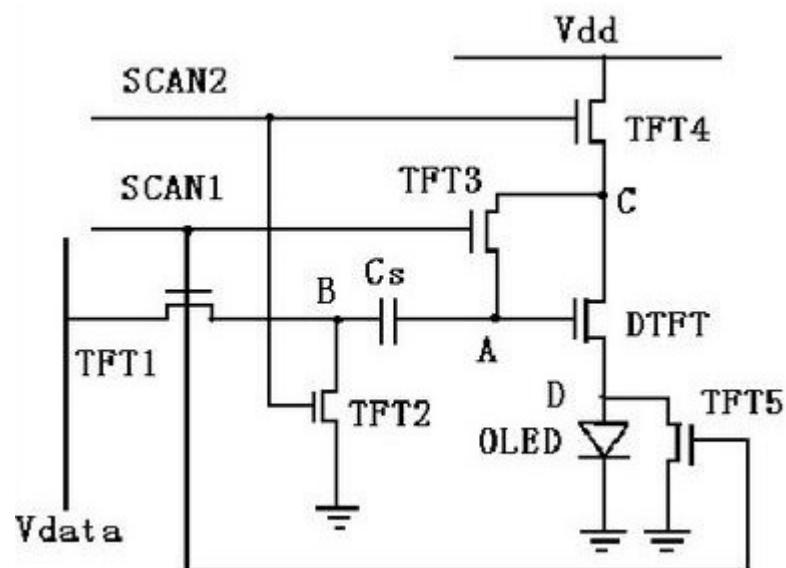


图1

专利名称(译)	一种像素电路		
公开(公告)号	CN109308873A	公开(公告)日	2019-02-05
申请号	CN201710617136.0	申请日	2017-07-26
[标]申请(专利权)人(译)	何学军		
申请(专利权)人(译)	何学军		
当前申请(专利权)人(译)	何学军		
[标]发明人	何学军		
发明人	何学军		
IPC分类号	G09G3/3225		
CPC分类号	G09G3/3225		
外部链接	Espacenet	Sipo	

摘要(译)

本发明公开了一种像素电路，包括：第一晶体管TFT1、第二晶体管TFT2、第三晶体管TFT3、第四晶体管TFT4、第五晶体管TFT5、电容CS、有机发光二极管OLED和晶体管DTFT。本发明的有益效果为：电路结构简单，成本较低，所用电子元器件较少。

